

講演分科日程表(分科別) I

東海大学 湘南キャンパス

大分類分科名 中分類分科名	3月11日(水)		3月12日(木)		3月13日(金)		3月14日(土)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
1 応用物理学一般								
1.1 応用物理一般・学際領域				P1 13:30 - 15:30		D12 16:30 - 19:00		
1.2 教育						P1 16:30 - 18:30		
1.3 新技術・複合新領域		D13 # 13:15 - 17:00		P2 13:30 - 15:30				
1.4 エネルギー変換・貯蔵	P1 9:30 - 11:30		D12 9:00 - 12:45					
1.5 資源・環境	D12 10:00 - 11:30			P3 13:30 - 15:30				
1.6 計測技術・計測標準					P1 9:30 - 11:30		D12 9:00 - 11:15	D12 13:00 - 14:15
1.7 超音波	P2 9:30 - 11:30	D12 13:15 - 17:15						
2 放射線								
2.1 放射線物理一般・検出器基礎			P1 9:30 - 11:30		A19 9:00 - 12:15	A19 14:00 - 16:00		
2.2 検出器開発		A19 16:15 - 18:00	P2 9:30 - 11:30			A19 # 16:15 - 19:00	A19 9:00 - 12:15	
2.3 放射線応用・発生装置・新技術	A19 9:00 - 11:45	A19 14:00 - 16:00	P3 9:30 - 11:30					
3 光・フォトンクス ※コードシェアセッションあり 3.5 と 3.14, 3.11 と 13.7(表の末尾, コードシェアセッションを参照)								
3.0 Optics and Photonics English Session					A15 9:00 - 11:15			
3.1 光学基礎・光学新領域					P2 9:30 - 11:30		A12 9:00 - 12:00	A12 13:00 - 14:15
3.2 材料・機器光学				A13 14:00 - 17:15	P3 9:30 - 11:30			
3.3 情報フォトンクス・画像工学					P4 9:30 - 11:30	A11 16:30 - 17:30	A11 9:00 - 12:15	A11 13:15 - 14:30
3.4 生体・医用光学			P4 9:30 - 11:30				A10 9:30 - 11:45	A10 13:00 - 14:30
3.5 レーザー装置・材料			P5 9:30 - 11:30			A13 16:30 - 18:45	A13 9:30 - 12:00	
3.6 超高速・高強度レーザー			A15 # 9:45 - 12:30	A15 14:00 - 17:45	P5 9:30 - 11:30	A15 16:30 - 19:00	A15 9:15 - 12:00	A15 * 13:00 - 15:00
3.7 レーザープロセス	A11 9:30 - 12:30	A11 14:00 - 18:00	A11 ## 9:30 - 11:30		A11 9:30 - 12:30	P2 16:30 - 18:30		
3.8 光計測技術・機器	A14 9:00 - 12:30	A14 14:00 - 18:00			P6 9:30 - 11:30		A14 9:00 - 11:30	A14 13:00 - 15:00
3.9 テラヘルツ全般		P1 16:00 - 18:00	A14 9:15 - 12:15	A14 13:30 - 17:00	A14 9:00 - 12:15	A14 16:15 - 19:00		
3.10 光量子物理・技術	A17 9:15 - 12:00	A17 14:00 - 16:45	P6 9:30 - 11:30					
3.11 フォトニック構造・現象	P3 9:30 - 11:30			A10 ※ 14:00 - 18:45	A10 9:00 - 12:15	A10 ※※ 16:30 - 18:45		
3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	A12 9:00 - 12:30	A12 14:00 - 18:00	A12 9:00 - 12:15		A12 9:00 - 12:30	P3 16:30 - 18:30		
3.13 半導体光デバイス			A17 9:00 - 13:00	A17 14:00 - 19:00		P4 16:30 - 18:30		
3.14 光制御デバイス・光ファイバー	A13 9:15 - 12:30	A13 14:00 - 16:45	A13 9:00 - 11:45		P7 9:30 - 11:30			
3.15 シリコンフォトンクス		A16 14:00 - 17:00	A16 9:30 - 12:30	A16 14:00 - 17:30	P8 9:30 - 11:30			
6 薄膜・表面 ※コードシェアセッションあり 6.6 と 12.2(表の末尾, コードシェアセッションを参照)								
6.1 強誘電体薄膜		P3 16:00 - 18:00			A21 9:00 - 12:30	A21 16:15 - 18:30	A21 9:00 - 12:00	
6.2 カーボン系薄膜	P4 9:30 - 11:30	C1 13:15 - 18:00	C1 9:00 - 11:45	C1 # 13:15 - 19:00				
6.3 酸化物エレクトロニクス	D10 9:00 - 11:45	D10 13:15 - 17:45	D10 9:00 - 11:45		D10 9:00 - 11:45	P5 16:30 - 18:30 D10 16:30 - 19:00	D10 9:30 - 11:45	D10 13:00 - 14:45
6.4 薄膜新材料	D8 9:00 - 11:45		D8 9:00 - 11:45	D8 # 13:15 - 18:30		P6 16:30 - 18:30		
6.5 表面物理・真空	D9 9:00 - 12:00			D13 13:15 - 17:00		P7 16:30 - 18:30		
6.6 プロープ顕微鏡			D9 10:00 - 11:45	P4 13:30 - 15:30		D9 16:30 - 19:30	D9 9:00 - 12:00	D9 13:00 - 15:00

会場名のアルファベットは建物名を表します。
(例:A1 は A棟にあります。B2 は B棟にあります)

<建物略称> A:6号館A D:16号館
B:6号館B E:松前記念館講堂
C:6号館C P:体育館

分科内招待講演あり
##Invited lecture of overseas researcherあり
* 光・量子エレクトロニクス業績賞(宅間宏賞)受賞記念講演あり
※ 応用物理学会業績賞(研究業績)受賞記念講演あり
※※ 女性研究者研究業績・人材育成賞(小館香椎子賞)受賞記念講演

講演分科日程表について

(例)

	3月11日(水)		3月12日(木)		3月13日(金)		3月14日(土)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
P3 9:30 - 11:30				A10 14:00 - 18:45	B1 9:00 - 12:15	B2 16:30 - 18:45	D9 9:00 - 12:00	D9 13:00 - 15:00
ポスター セッションのみ				場内の記号 (A10会場)		講演時間		

講演分科日程表(分科別) II

東海大学 湘南キャンパス

大分類分科名 中分類分科名	3月11日(水)		3月12日(木)		3月13日(金)		3月14日(土)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
7 ビーム応用								
7.1 X線技術	P5 9:30 - 11:30	A26 13:15 - 17:30						
7.2 電子ビーム応用			P7 9:30 - 11:30	A11 13:30 - 19:00				
7.3 微細パターン・微細構造形成技術	B2 9:00 - 11:45	B2 # 13:15 - 16:30	P8 9:30 - 11:30					
7.4 量子ビーム界面構造計測						P8 16:30 - 18:30	A16 9:00 - 12:00	
7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術					A16 # 10:30 - 12:00	P9 16:30 - 18:30		
7.6 イオンビーム一般						P10 16:30 - 18:30	C1 9:00 - 12:00	C1 13:00 - 15:00
8 プラズマエレクトロニクス								
8.0 Plasma Electronics English Session			D14 9:00 - 10:45		P9 9:30 - 11:30			
8.1 プラズマ生成・制御				P9 16:00 - 18:00		A28 16:30 - 19:00	A28 9:00 - 11:45	
8.2 プラズマ診断・計測		A27 14:00 - 18:00			P10 9:30 - 11:30			
8.3 プラズマ成膜・表面処理				P10 16:00 - 18:00	A27 9:00 - 12:30			
8.4 プラズマエッチング					P11 9:30 - 11:30		A27 9:00 - 13:00	
8.5 プラズマナノテクノロジー					P12 9:30 - 11:30	A27 16:30 - 18:45		
8.6 プラズマライフサイエンス				P11 16:00 - 18:00	A28 9:00 - 12:15			
8.7 プラズマ現象・新応用・融合分野		A28 14:00 - 18:00				P11 16:30 - 18:30		
8.8 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演			D14 # 11:00 - 11:30					
プラズマエレクトロニクス賞授賞式			D14 11:30 - 11:45					
9 応用物性								
9.1 誘電材料・誘電体		P4 16:00 - 18:00	B5 9:00 - 12:30					
9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子			A20 9:30 - 12:15	A20 14:00 - 18:30		P12 16:30 - 18:30		
9.3 ナノエレクトロニクス						P13 16:30 - 18:30	A20 9:00 - 11:45	A20 13:00 - 14:45
9.4 熱電変換			A22 9:00 - 12:30	A22 14:00 - 18:00	A22 9:00 - 12:30	P14 16:30 - 18:30		
9.5 新機能材料・新物性	A20 10:00 - 11:45	A20 14:00 - 16:30		P5 13:30 - 15:30				
10 スピントロニクス・マグネティクス								
10.1 新物質創成(酸化物・ホイスラー・金属磁性体等)		D11 15:45 - 18:30	D11 9:00 - 11:45					
10.2 スピントルク・スピン流・回路・測定技術				D11 13:15 - 18:30				
10.3 GMR・TMR・磁気記録技術		P5 13:30 - 15:30				D11 16:15 - 18:15		D11 ※※ 13:00 - 15:00
10.4 半導体・有機・光・量子スピントロニクス							D2 ** 9:00 - 12:00	D2 13:00 - 15:00
10.5 磁場応用							D11 9:00 - 12:00	
11 超伝導								
11.1 基礎物性		A2 14:00 - 16:45		A2 13:30 - 18:00				
11.2 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長				A1 14:00 - 17:30		A1 12:00 - 19:00		
11.3 臨界電流, 超伝導パワー応用		A1 14:00 - 18:00	P9 9:30 - 11:30					
11.4 アナログ応用および関連技術				A3 14:00 - 17:00			A3 9:00 - 12:00	
11.5 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用						A2 16:15 - 17:30	A2 9:00 - 12:00	
12 有機分子・バイオエレクトロニクス ※ コードシェアセッションあり 6.6 と 12.2(表の末尾, コードシェアセッションを参照)								
12.1 作製・構造制御	D2 9:00 - 12:00	D2 13:15 - 18:00	D2 9:00 - 11:30			P13 9:30 - 11:30		
12.2 評価・基礎物性				P6 13:30 - 15:30		D14 16:30 - 19:00	D14 9:00 - 12:00	D14 13:00 - 15:00
12.3 機能材料・萌芽的デバイス	D4 9:00 - 11:45	D4 13:15 - 17:45	D4 9:00 - 11:30	D4 13:15 - 17:45	D4 # 9:00 - 11:00	P15 16:30 - 18:30		
12.4 有機EL・トランジスタ	D3 9:30 - 11:45	D3 13:15 - 18:00	D3 9:00 - 11:45	P12 16:00 - 18:00	D3 9:00 - 11:45		D3 9:15 - 12:00	D3 13:00 - 15:00
12.5 有機太陽電池	D15 9:00 - 11:45	D15 # 13:15 - 18:00	D15 9:00 - 11:30	P7 13:30 - 15:30	D15 9:00 - 12:00	D15 # 16:30 - 19:00	D15 9:00 - 12:00	D15 13:00 - 15:00
12.6 ナノバイオテクノロジー	D5 9:30 - 11:45	D5 13:15 - 18:00	P10 9:30 - 11:30		D5 9:30 - 11:45	D5 16:30 - 19:00		
12.7 医用工学・バイオチップ	D6 9:00 - 11:45	D6 13:15 - 18:00	P11 9:30 - 11:30		D6 9:00 - 11:45	D6 16:15 - 19:15	D6 9:00 - 12:00	

会場名のアルファベットは建物名を表します。
(例:A1 は A棟にあります。B2 は B棟にあります)

<建物略称>

A:6号館A D:16号館
B:6号館B E:松前記念館講堂
C:6号館C P:体育館

分科内招待講演あり

** 化合物半導体エレクトロニクス業績賞(赤崎勇賞)受賞記念講演あり

※※ 女性研究者研究業績・人材育成賞(小館香椎子賞)受賞記念講演

講演分科日程表(分科別)Ⅲ

東海大学 湘南キャンパス

大分類分科名 中分類分科名	3月11日(水)		3月12日(木)		3月13日(金)		3月14日(土)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
13 半導体 ※コードシェアセッションあり 3.11と13.7,13.10と15.2(表の末尾,コードシェアセッションを参照)								
13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション	A27 9:00 - 12:30		A27 10:00 - 12:30	A27 14:00 - 18:00		P16 16:30 - 18:30		
13.2 探索的材料物性・基礎物性				P8 13:30 - 15:30	A25 9:00 - 12:30	A25 16:15 - 19:15	A25 9:00 - 12:00	A25 13:00 - 14:00
13.3 絶縁膜技術			P12 9:30 - 11:30		A24 9:00 - 12:30		A24 9:00 - 12:15	
13.4 Siプロセス・配線・MEMS・集積化技術	A29 9:00 - 12:30	A29 14:00 - 17:30	A29 9:00 - 12:00		P14 9:30 - 11:30		A29 9:00 - 12:00	A29 13:00 - 15:00
13.5 デバイス/集積化技術	A23 9:00 - 12:15	A23 14:00 - 17:30	P13 9:30 - 11:30	A23 ※ 14:00 - 17:30	A23 9:00 - 12:30	A23 16:15 - 19:00		
13.6 Semiconductor English Session			A23 9:00 - 12:15					
13.7 超薄膜・量子ナノ構造	A10 9:15 - 12:30			A24 14:00 - 15:45 P13 16:00 - 18:00				
13.8 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	A21 9:00 - 12:00	A21 14:00 - 17:15	A21 9:00 - 12:30	A21 14:00 - 17:30		P17 16:30 - 18:30		
13.9 光物性・発光デバイス	A25 9:30 - 12:15	A25 13:30 - 17:30	A25 9:00 - 12:30	A25 14:00 - 17:00		P18 16:30 - 18:30		
13.10 化合物太陽電池			A26 10:00 - 12:00		A26 9:30 - 12:15		A26 9:30 - 12:00	
15 結晶工学 ※コードシェアセッションあり 13.10と15.2(表の末尾,コードシェアセッションを参照)								
15.1 バルク結晶成長			D13 9:30 - 11:45	P14 16:00 - 18:00			D13 10:00 - 12:00	
15.2 II-VI族結晶および多元系結晶				P15 16:00 - 18:00		A17 16:15 - 19:15		
15.3 III-V族エピタキシャル結晶					P15 9:30 - 11:30	D4 16:15 - 19:00	D4 9:00 - 11:30	D4 13:00 - 14:15
15.4 III-V族窒化物結晶	B1 8:30 - 11:45	B1 13:15 - 18:45	B1 8:30 - 11:45	B1 ※※ 13:15 - 19:45 P16 16:00 - 18:00	B1 8:30 - 13:00	B1 16:15 - 18:00		
15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶	D7 9:00 - 12:00	D7 13:30 - 17:15	D5 10:00 - 12:00	P17 16:00 - 18:00				
15.6 IV族系化合物		P2 13:30 - 15:30	B4 9:00 - 11:45		B4 9:00 - 11:45	B4 16:15 - 18:30	B4 9:00 - 12:30	
15.7 エピタキシーの基礎					P16 9:30 - 11:30			D4 14:15 - 15:00
15.8 結晶評価, 不純物・結晶欠陥				A18 14:00 - 19:00	P17 9:30 - 11:30			
16 非晶質・微結晶								
16.1 基礎物性・評価		P6 16:00 - 18:00	A28 9:15 - 12:30	A28 14:00 - 17:15				
16.3 シリコン系太陽電池	C2 9:00 - 12:30	C2 14:00 - 15:45 P6 16:00 - 18:00	A18 9:00 - 12:30	C2 13:45 - 19:00	C2 9:00 - 11:00			
17 ナノカーボン								
17.1 成長技術			D6 10:15 - 11:45	D7 13:15 - 19:00				D7 14:30 - 15:15
17.2 構造制御・プロセス			D7 9:00 - 11:45 D6 9:15 - 10:15			D8 18:30 - 19:00		
17.3 新機能探索・基礎物性評価	P6 9:30 - 11:30	D8 16:45 - 18:00			D8 9:00 - 11:45 D7 9:30 - 11:45	D8 16:15 - 18:30		
17.4 デバイス応用				D6 13:15 - 16:45			D7 9:00 - 12:00	D7 13:00 - 14:30
合同セッションK ワイドギャップ酸化半導体材料・デバイス								
合同セッションK ワイドギャップ酸化半導体材料・デバイス	D1 9:30 - 11:45	D1 13:15 - 17:45	D1 9:00 - 12:15		P18 9:30 - 11:30	D1 16:15 - 19:15	D1 9:00 - 11:30	

会場名のアルファベットは建物名を表します。
(例:A1はA棟にあります。B2はB棟にあります)

<建物略称>

A:6号館A
B:6号館B
C:6号館C
D:16号館
E:松前記念館講堂
P:体育館

分科内招待講演あり

※ 応用物理学会業績賞(研究業績)受賞記念講演あり

※※ 女性研究者研究業績・人材育成賞(小館香椎子賞)受賞記念講演

講演分科日程表(分科別)IV

東海大学 湘南キャンパス

大分類分科名 中分類分科名	3月11日(水)		3月12日(木)		3月13日(金)		3月14日(土)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
特別シンポジウム								
応用物理分野で活躍する女性達-第3回バイオエレクトロニクス編-					B3 9:00 - 12:00			
フォノンエンジニアリング:ナノスケール熱制御のための新しい材料科学、理論・シミュレーション、計測技術、およびこれによるデバイス革新							B2 8:45 - 15:00	
世界一行きたい科学広場in 東海大学湘南キャンパス 第一部:シンポジウム							F1 9:00 - 10:50	
世界一行きたい科学広場in 東海大学湘南キャンパス 第二部:科学広場と科学ショー							E1 11:00 - 15:00	
かながわ発! スマートエネルギー革命			E1 13:00 - 16:45					
産学協働研究会設立シンポジウム-日本のモノづくり再生に向けた産学官共鳴場の創成を目指して-			B2 13:30 - 17:30					
シンポジウム								
フォトニクスと量子情報技術の融合へ向けて		B4 13:30 - 17:15						
斜め蒸着法、GLAD、STF等、シャドウイングによるナノ形態の制御と評価		D9 13:15 - 17:00						
最先端CMOS技術とその将来展望		B5 13:15 - 17:30						
放射線オプティクス			A19 14:00 - 17:15					
レーザーによる3次元造形技術の最先端から実用まで			B6 13:30 - 18:00					
光量子を自在に操る分極反転光デバイス			D2 13:15 - 17:00					
散逸ゆらぎ制御ナノ電子フォトン系の理論とデバイス構築			A12 14:00 - 17:45					
宇宙観測・地球観測で活用される光センシング技術			B3 13:30 - 16:15					
次世代強誘電体材料の開発指針			B5 13:30 - 17:30					
スピン-軌道相互作用が生み出す酸化物の新しい機能性			D10 13:15 - 18:30					
二酸化チタンの最近の動向			D9 13:15 - 17:30					
リソグラフィ技術の最新動向			C3 13:15 - 15:30					
微粒子合成法とその応用最前線			D14 13:30 - 18:45					
バイオインターフェースの可視化・実用技術の新展開			D5 13:15 - 17:15					
未来を担う若手科学者の在り方 ~集積化技術の新たな価値創造を目指して~			A29 13:00 - 17:00					
クルマ社会の未来を支えるセンシング技術 ~自動運転システムの展望と課題~			D15 14:00 - 17:15					
酸化物半導体における価電子メタモルフォロジ			D1 13:15 - 18:30					
進化するパワー半導体...シリコンからワイドバンドギャップへ			B4 13:15 - 18:15					
衝撃および重力場応用の物理の最前線					D13 9:00 - 13:00			
スピントロニクスの将来ビジョン ~スピントロニクスはこれから何をやるのか?~					B6 9:00 - 12:30			
巨匠が教えてくれた高温超伝導とその未来~北澤宏一先生・前田弘先生追悼シンポジウム~					B2 9:00 - 11:45	B2 16:15 - 18:45		
太陽電池用バルク結晶シリコンの成長と評価						C2 13:15 - 18:15		
窒化物半導体特異構造の科学 ~成長・プロセスとエレクトロニクス展開~							B1 8:30 - 11:45	B1 12:45 - 15:00
最先端の電子・集束イオンビーム装置技術		B3 13:15 - 17:15						
化合物薄膜とペロブスカイト太陽電池融合の可能性	B6 9:00 - 11:45	B6 13:15 - 17:00						
コードシェアセッション								
3.5 レーザー装置・材料, 3.14 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション					A13 9:00 - 11:15			
3.11 フォトリソグラフィ・現象, 13.7 超薄膜・量子ナノ構造のコードシェアセッション			A10 9:00 - 12:30					
6.6 プローブ顕微鏡, 12.2 評価・基礎物性のコードシェアセッション					D14 9:00 - 12:00			
13.10 化合物太陽電池, 15.2 II-VI族結晶および多元系結晶のコードシェアセッション			A26 13:30 - 17:45		A17 9:00 - 12:15	P19 16:30 - 18:30		

会場名のアルファベットは建物名を表します。
(例:A1はA棟にあります。B2はB棟にあります)

<建物略称>

A:6号館A
B:6号館B
C:6号館C
D:16号館
E:松前記念館講堂
P:体育館